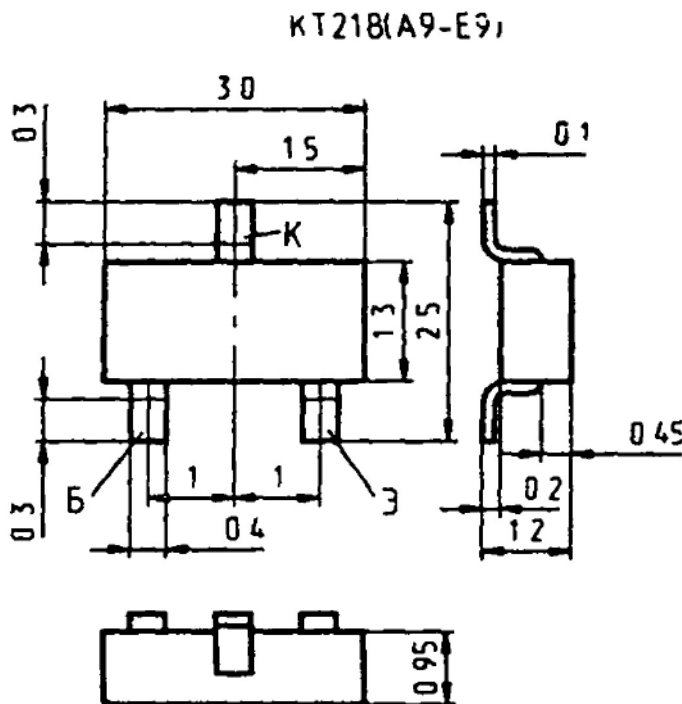


КТ218А9, КТ218Б9, КТ218В9, КТ218Г9, КТ218Д9, КТ218Е9

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* универсальные. Предназначены для применения в усилителях, генераторах и импульсных устройствах в составе гибридных интегральных микросхем с общей герметизацией. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается в этикетке.



Масса транзистора не более 0,1 г.

Изготовитель — акционерное общество открытого типа «Элекс», г. Александров.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 10$ мА для КТ218А9, КТ218Б9, КТ218В9, КТ218Г9 и $U_{КБ} = 1$ В, $I_3 = 0,04$ мА для КТ218Д9, КТ218Е9:

КТ218А9, не менее	20
КТ218Б9	30...90
КТ218В9, КТ218Г9	40...120
КТ218Д9, не менее	80
КТ218Е9, не менее	40

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 1$ мА, не менее 5 МГц

Граничное напряжение при $I_3 = 10$ мА, не менее:

КТ218А9, КТ218Б9	80 В
------------------------	------

КТ218В9	60 В
КТ218Г9	40 В
КТ218Д9	30 В
КТ218Е9	20 В
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_k = 10$ мА, $I_b = 1$ мА, не более	0,6 В
Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_k = 10$ мА, $I_b = 1$ мА, не более	1,2 В
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 10$ В, не более	15 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 0,5$ В, не более	20 пФ
Обратный ток коллектор—эмиттер при $R_{бэ} = 10$ кОм, не более:	
КТ218А9 при $U_{кэ} = 100$ В	1 мкА
КТ218Б9 при $U_{кэ} = 90$ В	1 мкА
КТ218В9 при $U_{кэ} = 80$ В	1 мкА
КТ218Г9 при $U_{кэ} = 60$ В	1 мкА
КТ218Д9, КТ218Е9 при $U_{кэ} = 30$ В	1 мкА
Обратный ток эмиттер—база при $U_{эб} = U_{эб, макс}$, не более	10 мкА

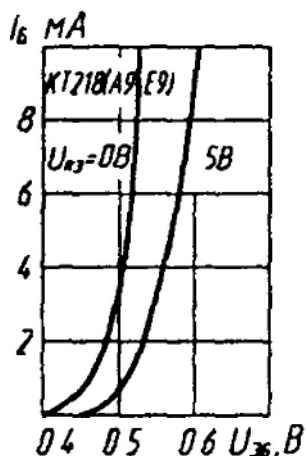
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{бэ} = 10$ кОм:	
КТ218А9, КТ218Б9	80 В
КТ218В9	60 В
КТ218Г9	40 В
КТ218Д9	30 В
КТ218Е9	20 В
Постоянное напряжение эмиттер—база:	
КТ218А9	30 В
КТ218Б9, КТ218В9, КТ218Д9	7 В
КТ218Е9	20 В
Постоянный ток коллектора	50 мА
Импульсный ток коллектора при $t_n = 10$ мс, $Q = 100$	125 мА
Постоянный ток базы	20 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора' при $T = -60...+25$ °С	200 мВт
Температура р-п перехода	+125 °С
Тепловое сопротивление переход—среда	500 °С/Вт
Температура окружающей среды	-60...+85 °С

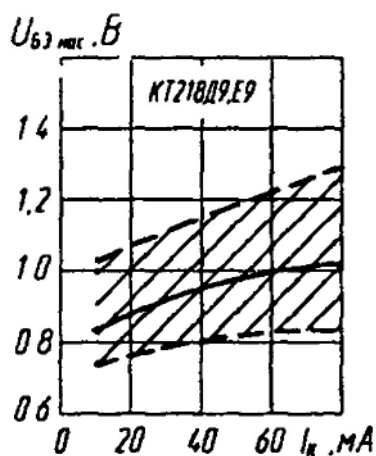
¹ При $T > +25\text{ }^{\circ}\text{C}$ максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора рассчитывается по формуле

$$P_{\text{к макс}} = (125 - T)/500, \text{ Вт.}$$

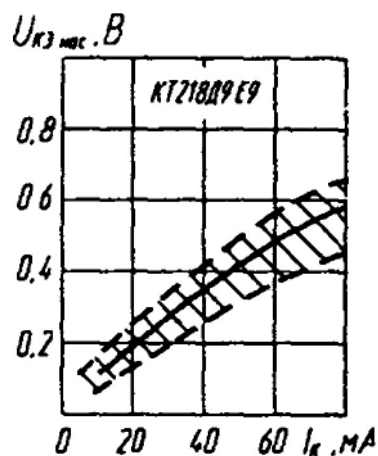
Пайку выводов рекомендуется проводить с применением лудящих паст и припоев на расстоянии не менее 0,15 мм от корпуса транзистора, время пайки не более 4 с, температура пайки не более $+265\text{ }^{\circ}\text{C}$.



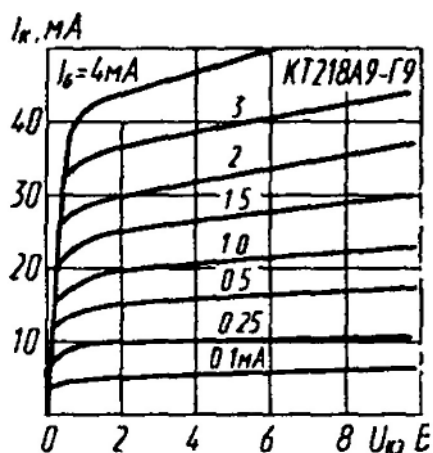
Входные характеристики



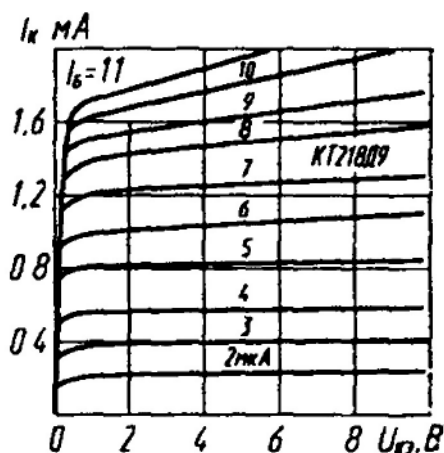
Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения база—эмиттер от тока коллектора



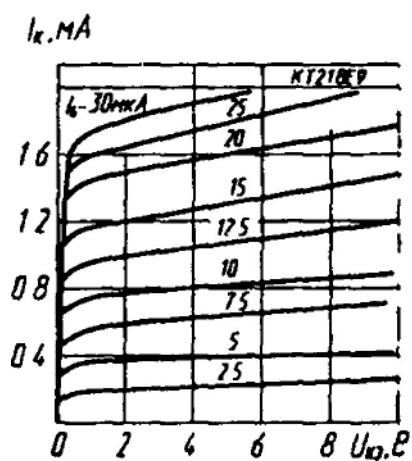
Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора



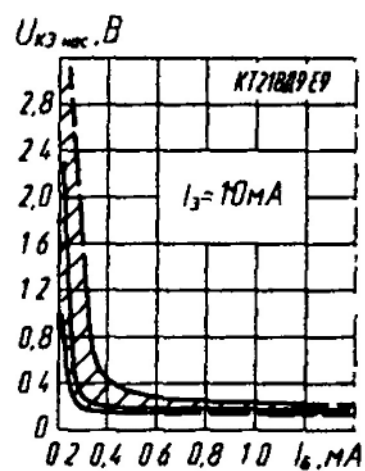
Выходные характеристики



Выходные характеристики



Выходные характеристики



Зона возможных положений
зависимости напряжения на-
сыщения коллектор—эмит-
тер от тока базы